

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-226282
 (43)Date of publication of application : 03.09.1993

(51)Int.Cl.

H01L 21/285
 H01L 21/285
 C23C 16/14
 H01L 21/90

(21)Application number : 04-025572
 (22)Date of filing : 13.02.1992

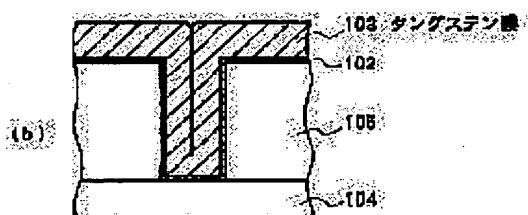
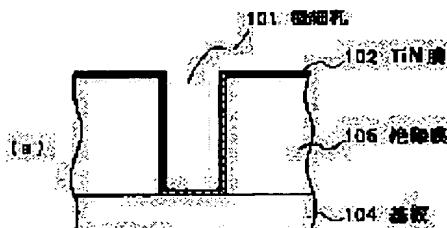
(71)Applicant : NEC CORP
 (72)Inventor : TSUNENARI KINJI

(54) METHOD FOR TUNGSTEN FILM FORMATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To fill a fine hole with a tungsten film each that excellent step coverage and smoothness will be ensured.

CONSTITUTION: WF6 is reduced in NH3 gas above a substrate so that a tungsten film may be deposited on the TiN coating 102 of a fine hole in the substrate by chemical vapor deposition. A very small amount of tungsten nitride is formed on the growth face of the tungsten film. The tungsten nitride appropriately reduces the catalytic activity of the growth face and unifies the crystal grain growth, obtaining a smooth film surface. In addition, the barrier feature of the tungsten nitride film itself surrounded with tungsten boundary is improved; accordingly, the substrate Si is not eroded. The surface reaction is controlled, and thus favorable step coverage is provided.



LEGAL STATUS

- [Date of request for examination] 30.07.1996
- [Date of sending the examiner's decision of rejection] 22.12.1998
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
- [Date of final disposal for application]
- [Patent number]
- [Date of registration]
- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-226282

(43)公開日 平成5年(1993)9月3日

(51)Int.Cl.⁵
H 01 L 21/285
C 23 C 16/14
H 01 L 21/90

識別記号 301 R 7738-4M
C 7738-4M
7325-4K
D 7735-4M

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全3頁)

(21)出願番号 特願平4-25572

(22)出願日 平成4年(1992)2月13日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 恒成 欣嗣

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式
会社内

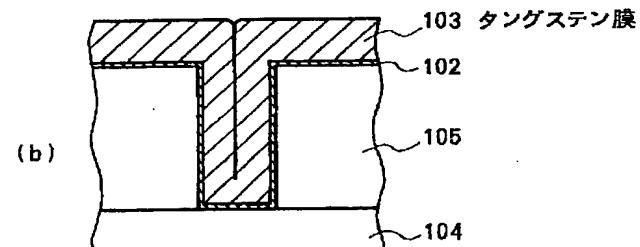
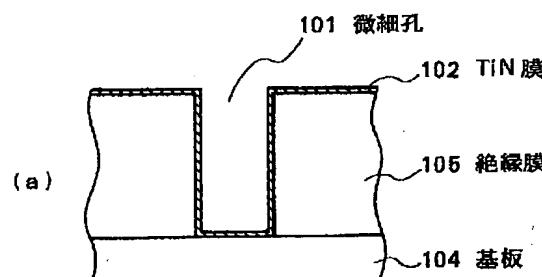
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54)【発明の名称】 タングステン膜の形成方法

(57)【要約】

【目的】 微細孔をタングステン膜で段差被覆性良く平滑に埋め込む。

【構成】 WF₆ をNH₃ガスで基板上で還元することにより、微細孔101内に被着されたTiN下地接着膜102上にタングステン膜103を化学気相成長する。タングステン膜成長面に微量の窒化タングステンが形成され、これがタングステン膜成長面の触媒活性を適当に低下させ結晶粒成長が均一化し、膜表面が平滑になる。またタングステン粒界にとりこまれる窒化タングステン膜自身のバリヤ性が向上するので下地Siを浸食しない。また表面反応律速であるので段差被覆性もよい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 NH_3 を含むガスでハロゲン化タンゲステンを還元して、段差を有する基板上にタンゲステン膜を形成することを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、コンタクト孔、微細溝等の段差が形成された基板上に化学的気相成長法でタンゲステン膜を形成する方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来の化学気相成長法によるタンゲステン薄膜の形成方法は、 WF_6 ガスを H_2 あるいは SiH_4 ガスで還元する方法が一般的であった。これらの方法には、基板のある特定の領域上（例えば Si や、シリサイドが露出している領域上）のみに選択的に成膜を行なう方法（選択成膜）と、あらかじめ基板上全面に、基板との接着層となる導電膜（例えば TiN 膜等）を形成し、その上にタンゲステン膜を全面成膜する方法がある。現状では、これらのうち、複数種類の深さをもつ微細孔を同時に埋め込むことができる利点から、全面成膜法が主流となっている。本発明も主に全面成膜法に適用する方法である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 上記の方法によると、以下に述べるような問題があった。

(1) WF_6 を H_2 で還元する方法

この方法で堆積した W 膜は、結晶粒が粗い。この結果、タンゲステン膜中を WF_6 ガスが透過しやすい。従って下地接着層の厚さが充分でないと、この接着層を介して下地 Si と WF_6 ガスとの反応が生じ、下地 Si が浸食されてしまう。一方、段差被覆性は比較的良好であるが結晶粒が粗く、微細孔の埋め込み途中に、ある一定の確率で巨大結晶粒が開口部を塞ぎ、それ以後の埋め込みが不可能になることがある。

(2) WF_6 を SiH_4 で還元する方法

この方法によれば、 H_2 還元法に比較して小さな結晶粒をもつ平滑な膜が得られる。しかし成膜反応が供給律速であるため、段差被覆性が極めて悪く、全面成膜法による微細孔の埋め込みには適していない。

【0004】 本発明の目的はタンゲステン膜を段差被覆性良くしかも平滑に形成する方法を提供することである。

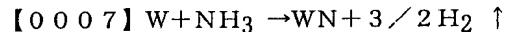
【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明の微細孔埋め込み方法では、 NH_3 をその一成分として含むガスによって WF_6 を還元することにより、基板上にタンゲステン薄膜を化学気相成長する。この方法により、 H_2 還元全面成膜法の特徴である良好な段差被覆性と SiH_4 還元法の特徴である細かい結晶粒と平滑な膜の両方の利点を合

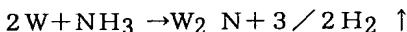
せもつタンゲステン膜を形成する。

【0006】

【実施例】 図1は本発明の実施例の工程縦断面図である。本発明の実施には、通常広く用いられている、いわゆるタンゲステン全面成膜用のコールドウォール型熱CVD装置を用いることができる。 SiO_2 等の絶縁膜105に、基板104に達するまで穿たれた微細孔101を形成し、次いでタンゲステンの核形成を可能にする下地膜として、 TiN 膜102をスパッタ法あるいはCVD法により約200Å形成する（図1a）。続いて、基板温度を300～450°Cに保ち、 WF_6 、 NH_3 、 H_2 流量をそれぞれ100sccm、300sccm、200sccmとし、全圧力30～100Torrで、 TiN 膜102上にタンゲステン膜103を形成し、微細孔101を埋め込む（図1b）。本発明によれば、タンゲステン膜形成中に、同時に次の反応によりタンゲステン膜成長面に微量の窒化タンゲステンが形成される。



あるいは



この窒化タンゲステンがタンゲステン膜成長面の触媒活性を適度に低下させ、タンゲステン膜表面の特定部分だけで WF_6 と NH_3 の反応が優位に進行するのを抑制する。この結果、結晶粒成長が均一化し、膜表面の平滑性が増す。また、タンゲステン粒界に取込まれた微量のタンゲステン窒化物により、タンゲステン膜自体のバリア性が向上し WF_6 の膜中拡散が抑制される。本法は、 H_2 還元法と同様、表面反応律速であるので、段差被覆性は良好である。これらの効果により、従来の全面成膜にみられる問題点が解消され、微細孔をより安定に埋め込むことが可能になる。

【0008】 なお前述の実施例では WF_6 を用いたが、 WCi_6 、 WI 、 WBf 等も用いることができる。また、本発明は微細孔の埋め込みに限らず微細溝、さらに一般に段差を有する基板上にタンゲステン膜を形成するときに適用できる。また多層配線間の層間接続等に用いえることもできる。

【0009】

【発明の効果】 本発明によれば、従来の方法と比較して、平滑でバリア性の高いタンゲステン膜を段差被覆性良く形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例の工程断面図である。

【符号の説明】

101 微細孔

102 TiN 膜

103 タンゲステン膜

104 基板

105 絶縁膜

【図1】

